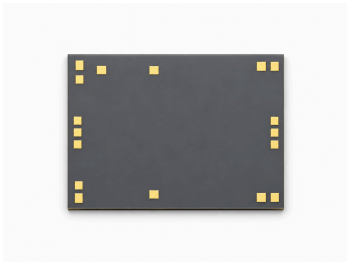


Die amplificatore di potenza GaN MMIC, 13000–15000 MHz

impulsato: PSAT: 42 dBm (tipico); Guadagno di potenza: 21 dB (tipico); PAE: 35 % (minimo) / 37 % (tipico). Dimensioni del die: 2.8 × 2 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF · TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; impulsato

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Frequenza operativa	f	13000	-	15000	13000–15000	MHz
Potenza di uscita satura	Psat	-	42	-	-	dBm
Guadagno di potenza	Gp	-	21	-	-	dB
Planarità del guadagno di potenza	ΔGp	-	±0.35	-	-	dB
Efficienza di potenza aggiunta	PAE	35	37	-	-	%
VSWR di ingresso	VSWR(in)	-	1.8	-	-	-

Polarizzazione DC e correnti · TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione di drain	Vd	24	28	32	V
Tensione di gate	Vg	-5	-3.05	-2.6	V
Corrente di drain a riposo	Id	-	0.11	-	A
Corrente dinamica di drain	Idd	-	1.7	-	A
Corrente dinamica di gate	Igg	-	0.5	-	mA

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Tensione drain-source massima	Vd	-	-	32	V
Polarizzazione minima del gate	Vg	-5	-	-	V
Potenza di ingresso massima	Pin	-	-	24	dBm
Temperatura di stoccaggio	TSTG	-65	-	150	°C
Temperatura massima del canale	Top	-	-	225	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	2.8 × 2 × 0.1	mm

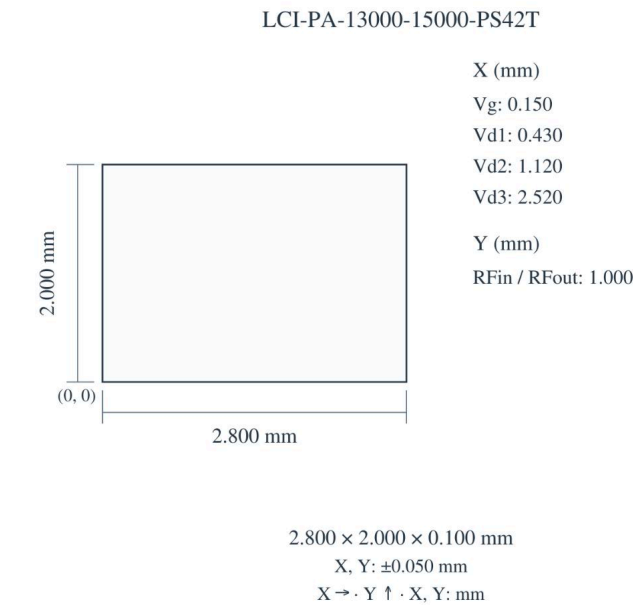
Integrazione del die e sequenza di polarizzazione

Blocco DC integrato: RFin / RFout. Percorso DC verso massa: RFin → GND. Caratterizzazione separata: Vd = +28 V; Vg = -3.05 V; CW; Pin = 21 dBm. Applicare la polarizzazione di gate prima di quella di drain. Rimuovere prima quella di drain. Si consiglia di alimentare la polarizzazione da entrambi i lati.

Ambito del riferimento meccanico

Profilo e riferimenti delle coordinate quotate nella fonte, in mm. Non costituisce un disegno completo di fabbricazione o di wire bonding.

Disegno dimensionale meccanico



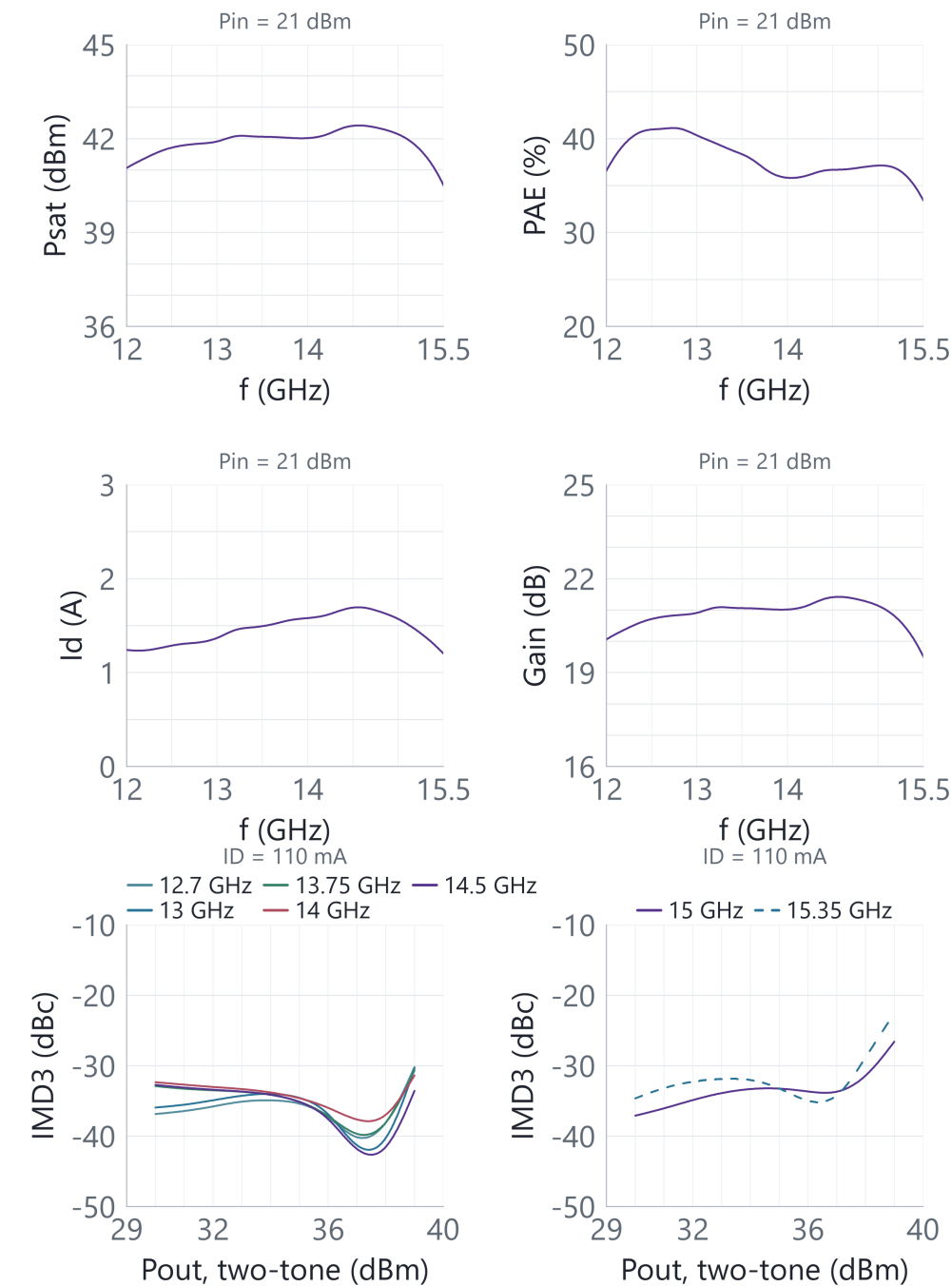
Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Curve di prestazione

Grafici tratti dalla scheda tecnica originale. Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.

Potenza di uscita satura; Efficienza di potenza aggiunta; Corrente dinamica di drain; Guadagno di potenza; IMD3.

Indicazione nella pagina originale: Vd=+28V; Vg=-3.05V. Grafico ridisegnato dalla figura originale; i valori letti sono approssimativi. Psat/PAE/Id/ Gain: Pin = 21 dBm. IMD3: Id = 110 mA.



Fonte

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.